GaAs pHEMT МАЛОШУМЯЩИЕ ПОЛЕВЫЕ СВЧ ТРАНЗИСТОРЫ

Тип	Фирма-произв.	Диапазон частот, ГГц	Затвор, мкм	Fизм., ГГц	NF, дБ	Ga, дБ [2]	Режим измерения Uси / Iс	P1дБ, дБм	Режим измерения Uси / Iс	Корпус
ATF-33143	Agilent Technologies	0,45 - 6	1600	2	0,5	15	4 В / 80 мА	+22	4 В / 80 мА	SOT-343
ATF-331M4					0,6	15	4 В / 60 мА	+19	4 В / 60 мА	MiniPak
ATF-34143		0,45 - 6	800	2	0,5	17,5	4 В / 60 мА	+20	4 В / 60 мА	SOT-343
ATF-54143 [1]		0,45 - 6	800	2	0,5	16,6	3 В / 60 мА	+20,4	3 В / 60 мА	SOT-343
ATF-541M4 [1]						17,5		+21,4		MiniPak
ATF-35143		0,45 - 10	400	2	0,4	18	2 В / 15 мА	+10	2 В / 15 мА	SOT-343
ATF-55143 [1]		0,45 - 6	400	2	0,6	17,7	2,7 В / 10 мА	+14,4	2,7 В / 10 мА	SOT-343
ATF-551M4 [1]					0,5	17,5		+14,6		MiniPak
ATF-38143		0,45 - 6	800	2	0,4	16	2 В / 10 мА	+12	2 В / 10 мА	SOT-343
ATF-58143 [1]		0,45 - 6	-	2	0,5	17,7	4 В / 30 мА	+21	4 В / 30 мА	SOT-343
ATF-36077		2 - 18	0,2 x 200	12	0,5	12	1,5 В/10 мА	+5	1,5 В/10 мА	70mil SM
ATF-36163		1,5 - 18	0,2 x 200	12	1,0	9,4	2 В / 15 мА	+5	2 В / 15 мА	SOT-363
NE3210S01	NEC	до 18	0,2 x 160	12	0,35	13,5	2 В / 10 мА	-	-	S01 plastic
NE4210S01		до 18	0,2 x 160	12	0,5	13	2 В / 10 мА	-	-	S01 plastic
NE4211M01		до 18	160	12	0,75	12	2 В / 10 мА	-	-	SOT-363
NE429M01		до 18	0,3 x 200	12	0,9	10	2 В / 10 мА	-	-	SOT-363
NE34018		до 6	0,6 x 400	2	0,6	16	2 В / 5 мА	+15	3 В / 30 мА	SOT-343
NE38018		до 6	0,6 x 800	2	0,55	14,5	2 В / 5 мА	+17…18	3 В / 30 мА	SOT-343
FHC40LG	Fujitsu	до 12	0,15 x 280	4	0,3	15,5	2 В / 10 мА	-	2 В / 10 мА	70mil SM
FHX04LG		до 18	0,25 x 200	12	0,75	10,5	2 В / 10 мА	-	2 В / 10 мА	70mil SM
FHX05LG					0,9					
FHX06LG					1,1					
FHX13LG		до 18	0,15 x 200	12	0,45	13,0	2 В / 10 мА	-	2 В / 10 мА	70mil SM
FHX14LG					0,55					
FHX35LG		до 18	0,25 x 280	12	1,2	10	3 В / 10 мА	-	3 В / 10 мА	70mil SM
MGF4953	Mitsubishi	до 18	-	12	0,4	13,5	2 В / 10 мА	-	-	GD-27
MGF4954		до 18	-	12	0,6	13,5	2 В / 10 мА	-	-	GD-27
LPD200MX	Filtronic Solid State	до 12	0,25 x 200	6	1,0 [3]	10	5 В / 30 мА	+17	5 В / 30 мА	SM plastic
LPD200SOT343		до 6		2	0,6	20	3 В / 15 мА	+15,5	3 В / 30 мА	SOT-343
LP6836SOT343		до 6	0,25 x 360	2	0,5	20	3 В / 25 мА	+19	3 В / 50 мА	SOT-343
FP750SOT343		до 6	0,25 x 750	2	0,5	17	3,3 В/ 60 мА	+21	3,3 В/110 мА	SOT-343
SPF-2086T	Sirenza	до 12	0,25 x 300	6	0,7	12,2	3 В / 20 мА	+20	5 В / 40 мА	SM plastic
SPF-2086TK		до 6	0,25 x 300	4	0,54	13,9	3 В / 20 мА	+20	5 В / 40 мА	SM plastic
SPF-3043		до 10	0,25 x 300	1,9	0,50	22	3 В / 20 мА	+20	5 В / 40 мА	SOT-343

[1] Транзисторы обогащенного типа с положительным напряжением затвор-исток.
[2] Коэффициент усиления в режиме минимального коэффициента шума.
[3] На частоте 1,8 ГГц в режиме 3 В / 15 мА.

GaAs МАЛОШУМЯЩИЕ ПОЛЕВЫЕ СВЧ ТРАНЗИСТОРЫ (MESFET)

Тип	Фирма-произв.	Диапазон частот, ГГц	Затвор, мкм	Fизм., ГГц	NF, дБ	Ga, дБ [1]	Режим измерения Uси / Iс	P1дБ, дБм	Режим измерения Uси, / Iс	Корпус
NE71383B	NEC	до 18	0,3 x 280	12	1,6	9,5	3 В / 10 мА	+14,5	3 В / 30 мА	70mil SM
NE722S01		до 12	0,8 x 400	4	0,9	12	3 В / 10 мА	+15	3 В / 30 мА	S01 plastic
FSU01LG	Fujitsu	до 4	-	2	0,55	18,5	3 В / 10 мА	+20	6 В / 40 мА	70mil SM
FSU02LG		до 4	-	2	1,5	17,5	3 В / 20 мА	+23	6 В / 80 мА	70mil SM
FSX017LG		до 12	-	12	-	9,2	-	+16	4 В / 30 мА	70mil SM
FSX017WF		до 12	-	8	2,5	10,5	3 В / 10 мА	+21,5	8 В / 40 мА	WF
FSX027WF		до 12	-	8	2,5	9,5	3 В / 30 мА	+24,5	8 В / 80 мА	WF
MGF1951A	Mitsubishi	до 18	-	12	-	9,0	3 В / 30 мА	+13	3 В / 30 мА	GD-27
MGF1952A		до 18	-	12	-	7,0	3 В / 60 мА	+17	3 В / 60 мА	GD-27
FH101	WJ	до 3	-	0,8	1,2	18	3,3 В / 70 мА	+18	5 В / 140 мА	SOT-89
FH1		до 3	-	0,8	1,2	18	3,3 В / 70 мА	+21	5 В / 140 мА	SOT-89
FHF1		3 - 6	-	3	2,4	12	3,3 В / 70 мА	+21	5 В / 140 мА	SOT-89

[1] Коэффициент усиления в режиме минимального коэффициента шума.

105005, Москва, ул. Радио, д.12, стр.2. Тел.: (095) 755-8815, факс (095) 755-8814, E-mail: sales@elcotech.ru

ОДНОЗАТВОРНЫЕ МОП-ТРАНЗИСТОРЫ С N-КАНАЛОМ

Тип	Фирма-произв.	G, дБ	NF, дБ	Режим измерения				Idss, мА	С вх., пФ	С вых, пФ	Пред. параметры			Корпус
				Uси, В	Iс, мА	f, мГц	Gs / Gl, мСм				Uси, В	Iс, мА	Рpacc., мВт	
S525T	Vishay	25	1,0	10	10	200	2 / 0,5	5…14	2,7	1,0	20	30	200	SOT-23
BF543	Infineon	22	1,0	10	4	200	2 / 0,5	2…6	2,7	0,9	20	30	200	
BF999	Infineon	25	1,0	10	10	200	2 / 0,5	5…18	2,5	1,0	20	30	200	

ДВУХЗАТВОРНЫЕ МОП-ТРАНЗИСТОРЫ С N-КАНАЛОМ

Тип	Фирма-произв.	G, дБ	NF, дБ	Режим измерения				Idss, мА	С вх., пФ	С вых, пФ	Пред. параметры			Корпус
				Uси, В	Iс, мА	f, мГц	Uз2и, В				Uси, В	Iс, мА	Рpacc., мВт	
BF961 **BF961A** **BF961B**	Vishay	20 [1]	1,8	15	10	200	+4	4…20 4…10,5 9,5…20	3,7	1,6	20	30	200	TO-50
BF964S **BF964SA** **BF964SB**		25 [1]	1,0	15	10	200	+4	4…18 4…10,5 9,5…18	2,5	1,0	20	30	200	TO-50
BF966S **BF966SA** **BF966SB**		18 [2]	1,8	15	10	800	+4	4…18 4…10,5 9,5…18	2,2	0,8	20	30	200	TO-50
BF988 **BF988A** **BF988B**		20 [2]	1,5	8	10	800	+4	4…18 4…10,5 9,5…18	2,1	1,05	12	30	200	TO-50
BF995 **BF995A** **BF995B**		20 [1]	1,8	15	10	200	+4	4…18 4…10,5 9,5…18	3,7	1,6	20	30	200	SOT-143
BF994S **BF994SA** **BF994SB**		25 [1]	1,0	15	10	200	+4	4…18 4…10,5 9,5…18	2,5	1,0	20	30	200	SOT-143
BF996S **BF996SA** **BF996SB**		18 [2]	1,8	15	10	800	+4	4…18 4…10,5 9,5…18	2,2	0,8	20	30	200	SOT-143
BF998 **BF998A** **BF998B**		20 [2]	1,5	8	10	800	+4	4…18 4…10,5 9,5…18	2,1	1,05	12	30	200	SOT-143
BF998 [4]	Infineon	20 [2]	1,0	8	10	800	+4	2…18	2,1	1,1	12	30	200	SOT-143
BF2030 [4]		23 [3]	1,5	5	10	800	+4	< 0,05	2,4	1,3	8	20	200	SOT-143
BF2040 [4]		23 [3]	1,6	5	15	800	+4	< 0,05	2,9	1,6	8	20	200	SOT-143

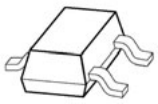
[1] Диапазон регулировки усиления не менее 50 дБ при изменении Uз2и от +4 до -2 В.
[2] Диапазон регулировки усиления не менее 40 дБ при изменении Uз2и от +4 до -2 В.
[3] Диапазон регулировки усиления не менее 45 дБ при изменении Uз2и от +4 до 0 В.
[4] Выпускаются также с индексом “R” с зеркальным расположением выводов.

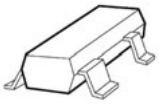
УСИЛИТЕЛИ С РЕГУЛИРУЕМЫМ УСИЛЕНИЕМ

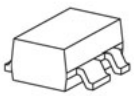
НА ДВУХЗАТВОРНЫХ МОП-ТРАНЗИСТОРАХ

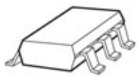
Тип	Фирма-произв.	G max, дБ	Диап. рег. Кр, дБ	NF, дБ	С вх., пФ	С вых, пФ	Uси max, В	Iс max, мА	Uп, В/ Iп, мА	Корпус
S594T	Vishay	20 [1]	>40 [3]	1,3 [1]	2,1	0,9	8	20	+5 / 10	SOT-143
S595T		21 [1]	>45 [3]	1,3 [1]	2,3	1,1	8	30	+5 / 13	
S849T		20 [2]	>40 [4]	1,3 [2]	2,1	0,9	16	30	+12 / 12	
S886T		22 [2]	>45 [4]	1,3 [2]	2,3	0,9	16	30	+12 / 12	

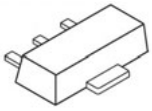
[1] Режим измерения: f=800 МГц, Gs=3,3 мСм; Gl=1 мСм, напряжение на 2-м затворе +4 В.
[2] Режим измерения: f=800 МГц, Gs=3,3 мСм; Gl=1 мСм, напряжение на 2-м затворе +6 В.
[3] Управляющее напряжение на 2-м затворе +1…+4 В.
[4] Управляющее напряжение на 2-м затворе +1…+6 В.

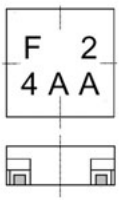

SOT-23


SOT-143


SOT-343

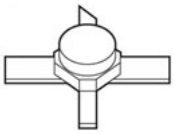

SOT-363

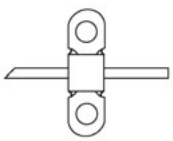

SOT-89



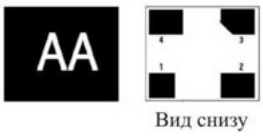
GD-27 (керамический)

SM plastic (“86”)


70 mil SM (“76”)


WF

TO-50



MiniPak

22.05.03

ООО «ЭЛКОТЕХ» - Поставка импортных электронных компонентов. 105005, г. Москва, ул. Радио, д. 12, стр.2. Тел.(095) 755-8815; факс (095) 755-8814; E-mail: sales@elcotech.ru; www.semiconductors.ru